

الکترونیک برتر با ماده ی د-بُعدی

با لایه‌ها ی د-بُعدی ی مُلبیدن-دی-سولفید (MoS_2) ترانزیستری ساخته اند که کارای ی ش بسیار بهتر از ترانزیسترها ی معمول است. ابزارها ی الکترونیک ی بر اساس این ترانزیستر را تحت تابش $[0.1 \text{ MJ (kg)}^{-1}]$ گاما گذاشته اند و معلوم شده مدت ی که این ترانزیستر جدید در برابر تابشها ی مخرب دوام می‌آورد 100 برابر مدت متناظر برا ی ترانزیسترها ی معمول است. نسبت وصل-به-قطع ترانزیستر جدید 10^8 است. توان ی که ترانزیستر جدید مصرف میکند هم پنج بار کمتر از توان مصرفی ی ترانزیسترها ی معمول است [1].

[1] Nature **650** 346